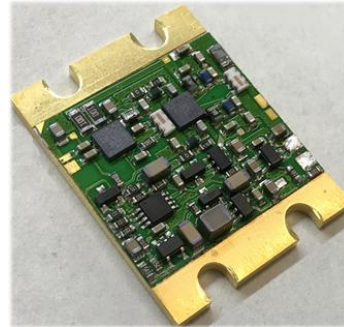


**特点:**

- 频率范围: 0.7~1.3GHz
- 增益: 31dB
- 输出 P<sub>-1dB</sub>: 36dBm
- SMT 封装
- 封装尺寸: 25.4×34×5.5mm<sup>3</sup>
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

**图片:**

**性能参数: (TA=+25°C, 50Ω 系统)**

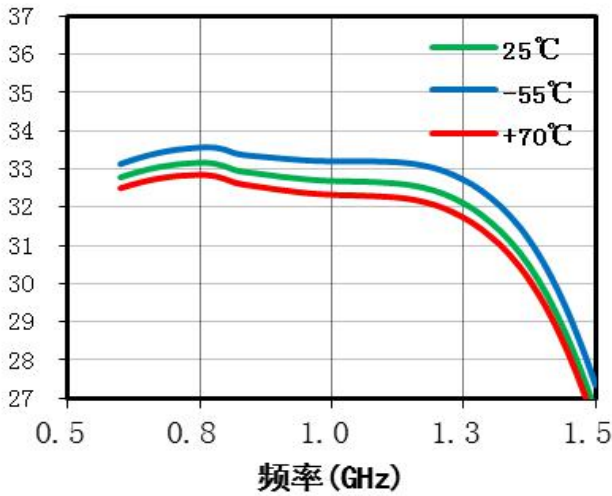
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注	
			MIN	TYP	MAX			
频率范围	f	V <sub>cc</sub> =+8.0V Z <sub>in</sub> =Z <sub>out</sub> =50Ω f=0.7~1.3GHz P <sub>in</sub> =-10dBm	0.7		1.3	GHz		
功率增益	G <sub>p</sub>		28	31	36	dB		
反向隔离度	ISO			-55		dB		
输入驻波比	VSWR <sub>i</sub>			1.5:1	2.2:1			
输出驻波比	VSWR <sub>o</sub>			1.5:1	2.0:1			
效率	PAE	V <sub>cc</sub> =+8.0V Z <sub>in</sub> =Z <sub>out</sub> =50Ω f=0.7~1.3GHz		33		%		
输出-1dB 压缩点	P <sub>-1dB</sub>		35	36		dBm		
杂散信号				-65		dBm		
开启时间				2		us		
关断时间				6		us		
控制电平 (开启)				4.2		5	V	
控制电平 (关断)				0		0.5	V	
工作电压	V <sub>cc</sub>		8		8.5	V		
电源电流	I <sub>cc</sub>	V <sub>cc</sub> =+8.0V		1.2	1.6	A		
工作温度	T		-55		+85	°C		
质量	m				10	g		

**极限参数表:**

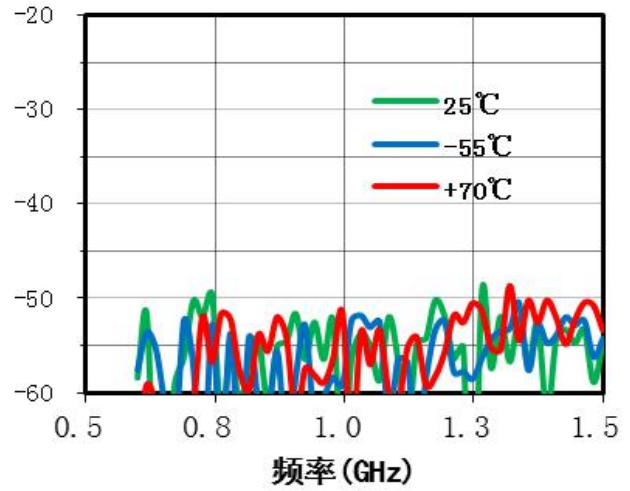
参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
输入射频功率	13.0	dBm	沟道温度	150	°C
储存温度	-55~+100	°C			

测试曲线:

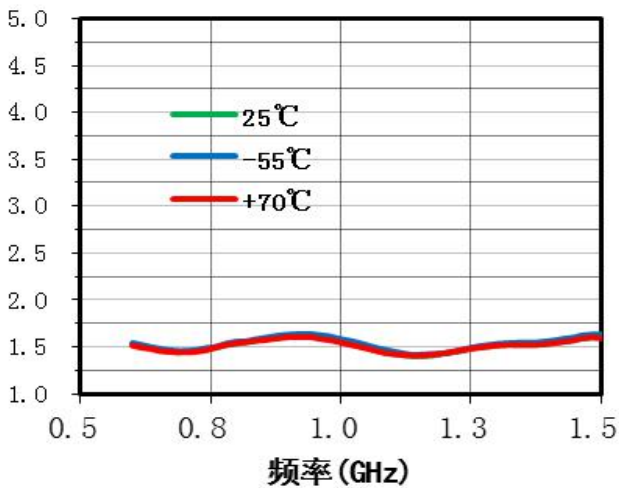
小信号增益 (dB) vs. 温度



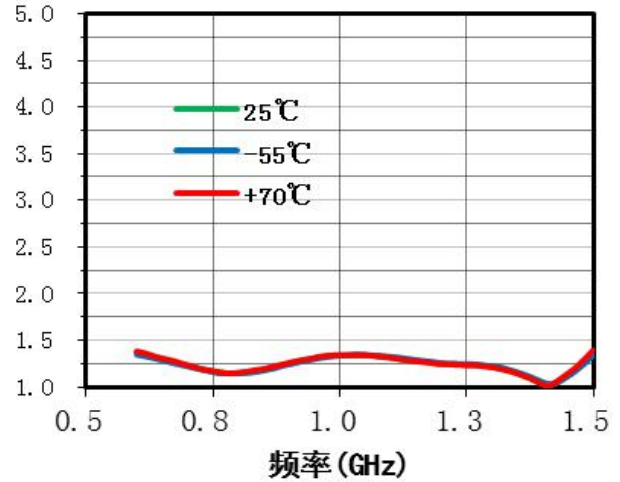
反向隔离度 (dB) vs. 温度



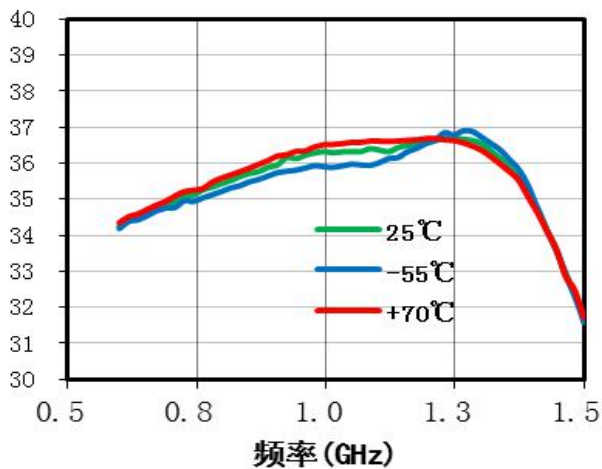
输入端口驻波比 (:1) vs. 温度



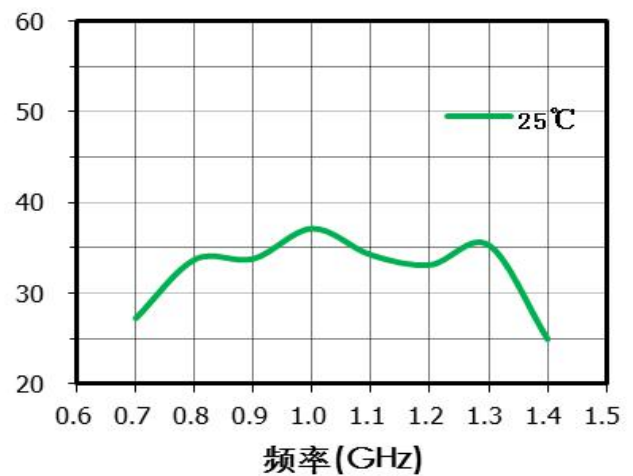
输出端口驻波比 (:1) vs. 温度



输出P-1dB (dBm) vs. 温度

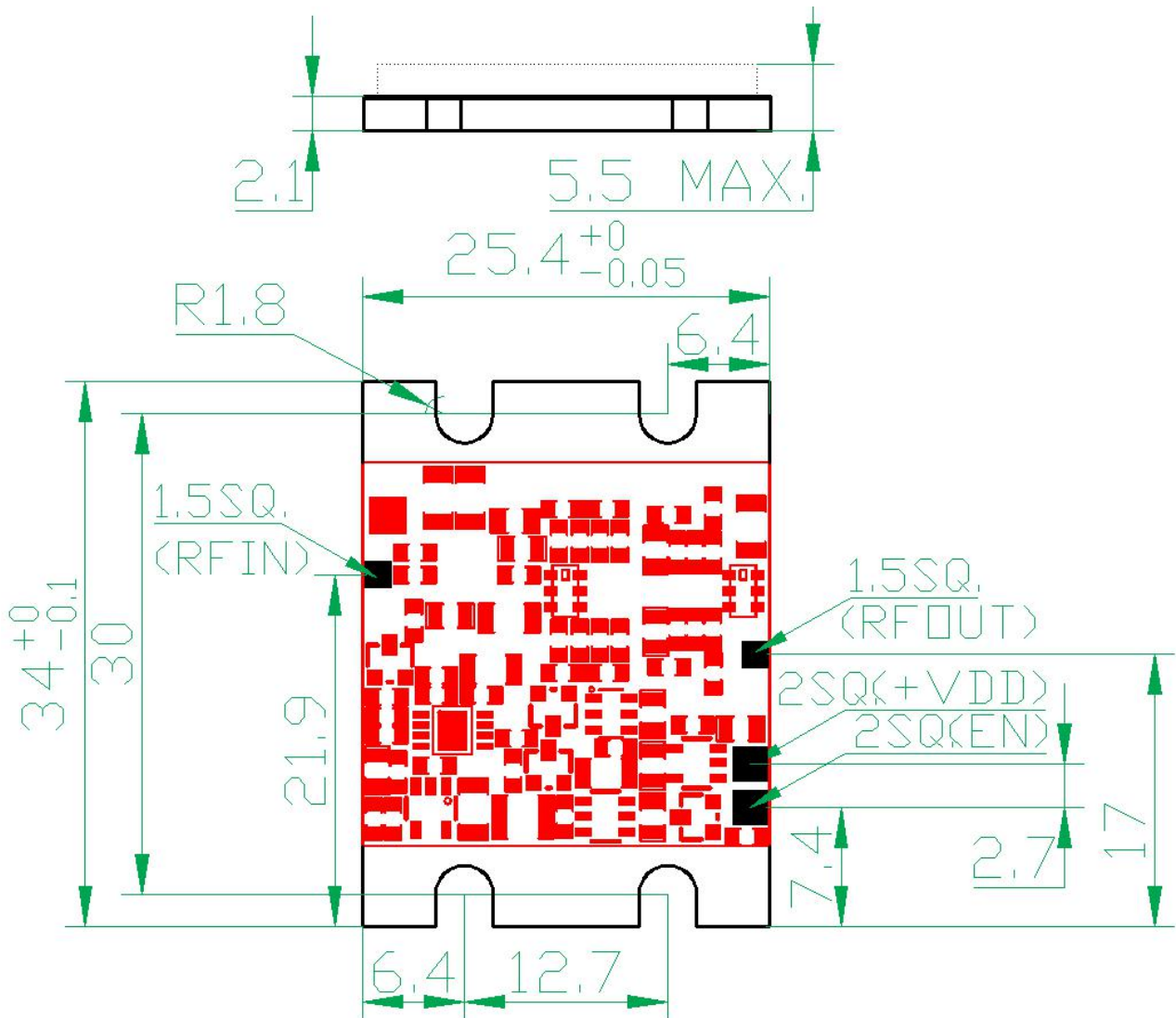


PAE (%)



**封装外形图:**

单位: mm 公差:  $\pm 0.2\text{mm}$



**产品使用注意事项:**

1. 产品属于静电敏感器件，耐静电能力 250~500V，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 模块用 M3 螺钉固定在外腔体中，装配时先用螺钉装配后再进行引脚焊接；
3. 射频端口和供电端口采用搭焊，供电端口注意承受电流能力，烙铁焊接温度为 280℃~350℃，每个焊点焊接时间 $\leq 3\text{s}$ 。
4. 装配时，应保护好表面器件，不能使其受损。
5. 拆卸时，需用吸锡带将每个焊点的焊锡清理干净，断开各个端口。
6. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
7. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。
8. 其他使用说明注意事项参考《成都宇熙产品使用说明》相关要求。